

France-Paris: Microelectronic machinery and apparatus**OJ S 242/2018 15/12/2018****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: CNRS Délégation Paris B

Postal address: 16 rue Pierre et Marie Curie

Town: Paris

NUTS code: FR101 Paris

Postal code: 75005

Country: France

Contact person: Secteur politique d'achats

E-mail: marchesdr2@dr2.cnrs.fr

Telephone: +33 142349400

Fax: +33 143268723

Internet address(es):Main address: <http://www.cnrs.fr>Address of the buyer profile: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Recherche

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'un bâti de croissance épitaxiale par jet moléculaires de semi-conducteurs

Reference number: 2018_PCN_CHAMBRE-MBE

II.1.2. Main CPV code

31712100 Microelectronic machinery and apparatus

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Le présent marché porte sur les prestations de fourniture, livraison, installation, mise en service et formation à l'utilisation d'un bâti de croissance épitaxiale par jets moléculaires de semi-conducteurs.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 507 913,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

NUTS code: FR10 Ile-de-France

Main site or place of performance: CNRS UMR 7588, institut des NanoSciences de Paris, université Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris.

II.2.4. Description of the procurement

L'objectif principal du système sera de fournir des matériaux 2D «au-delà du graphène», notamment les chalcogénures lamellaires, à divers collaborateurs, intéressés par ces matériaux, non seulement pour des études fondamentales de physique, mais aussi pour la création de la prochaine génération de dispositifs électroniques, optoélectroniques et spintroniques.

Étant donné que les propriétés électroniques de ces matériaux sont très sensibles au nombre de couches dans le film mince, le système MBE doit être capable de fournir des échantillons hautement homogènes (en termes d'épaisseur et de composition) sur un substrat de 2 pouces. Cette nouvelle chambre de croissance MBE sera connectée sur un tunnel ultravide couplant les systèmes de croissance existant actuellement et d'autres chambres annexes. Ceci permettra le transfert en conditions ultravide des échantillons produit dans cette nouvelle chambre vers les autres chambres de croissance et vers les chambres d'analyse (XPS, STM). L'ensemble du dispositif existant utilise un porte-échantillon de type «molyblock» RIBER 32P pour les substrats de 2 pouces de diamètre et un système de transfert frontal (échantillon en position verticale).

Voir le CCP pour les spécifications techniques.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Valeur technique / Weighting: 50

Quality criterion - Name: Qualité du SAV / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Développement durable / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Délai de livraison / Weighting: 5

Cost criterion - Name: Au regard du coût global / Weighting: 18

Cost criterion - Name: Par rapport au coût estimatif d'entretien annuel au regard du coût des pièces détachées et des consommables / Weighting: 6

Cost criterion - Name: Par rapport au coût de la maintenance / Weighting: 6

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

L'évaluation du premier sous-critère technique s'appuiera sur les retours d'expérience d'utilisateurs d'équipements similaires.

Le candidat est donc invité à communiquer, à l'appui de son dossier de candidature, la liste de ses 3 meilleures références (au maximum) indiquant les coordonnées d'une personne pouvant être contactée.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 110-250060](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2021041

Title:

Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'un bâti de croissance épitaxiale par jet moléculaires de semi-conducteurs

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/11/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 7

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 5

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 1

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: SVT Associates

National registration number: 876868647

Postal address: 7620 Exécutive Drive

Town: Eden Prairie

NUTS code: 00 Other or Not Specified

Postal code: MN 55344
Country: United States
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 507 913,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Une avance de 30 % sera versée au titulaire dans les 30 jours suivant la notification du marché conformément à l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, sauf refus stipulé par le titulaire dans l'acte d'engagement (ATTRI1).

L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie. Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte, de règlement partiel ou définitif ou de solde.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant initial du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal administratif de Paris

Postal address: 7 rue de Jouy

Town: Paris Cedex 04

Postal code: 75181

Country: France

E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Telephone: +33 144594400

Fax: +33 144594646

Internet address: <http://paris.tribunal-administratif.fr/>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Tribunal administratif de Paris

Postal address: 7 rue de Jouy

Town: Paris Cedex 04

Postal code: 75181

Country: France

E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Telephone: +33 144594400

Fax: +33 144594646

Internet address: <http://paris.tribunal-administratif.fr/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/12/2018